تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی فاطمه روزبان'، نرگس قجری بردر' ، سید محمد حسینی'، مجید ابراهیمی زاده ابریشمی' 'گروه فیزیک (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک) دانشگاه فردوسی مشهد

چکیدہ

اثر افزودنی مس بر روی خواص نانو پودرهای اکسید روی تهیه شده به روش سل-ژل با ترکیب Zn_{1-x}Cu_xO (۵۰٬۰، ۲۰٬۰۰ (۲۰۰۰ x)، مورد مطالعه قرار گرفته است. در دمای تکلیس C ۵۰۰ نمونه های Zn_{1-x}Cu_xO به ازاء (۲۰٬۰ ، ۲۰٬۰۰ (x) = x) دارای ساختار ورتسایت هستند ولی در نانو پودر O_۵، ۲۵ C سی² Zn_{1-x}Cu_xO فاز ثانویه منوکلینیک مشاهده شد. ساختار نانو پودرها با استفاده از پراش پرتو X مورد مطالعه قرار گرفت . مشخصه یابی نوری با استفاده از طیف سنجی فروسرخ انجام گردید و تأثیر مس بر طیف بازتابش در محدودهی فروسرخ میانی مورد تحلیل قرار گرفت. در ناحیه ی فراینفش نیز، گاف نوری با استفاده از طیف جذب محاسبه شد که شاهد کاهش گاف نوری با افزایش درصد مس بودیم.

The effect of doping Cu on ZnO nanostructures

Roozban , Fateme¹ ; Ghajari Bardar, Narges¹ ; Hosseini, Seyed Mohammad¹; Ebrahimizadeh Abrishami, Majid¹

¹ Department of Physics (Material and Electroceramic Laboratory), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

Abstract

In this work, the effect of Cu on properties of Zn nanopowder prepared by sol-gel technique with composition of $Zn_{1-x}Cu_xO(x=0.00, 0.02, 0.05)$ have been studied. The results indicated that when the sample $Zn_{1-x}Cu_xO(x=0.00, 0.02)$ calcinated at 500 °C the structure is wurtzite, but secondary monoclinic phase were observed in sample $Zn_{0.95}Cu_{0.05}O$. The structure of nanopowders was studied by X-ray diffraction. Optical characterization was performed by IR spectroscopy and the effect of Cu on reflectance spectrum in mid-IR region was investigated. In UV region the optical gap decrease with increasing Cu content.

PACS No. 61

چسبندگی خوب، قدرت پوشش عالی، مقاومت کافی در مقابل پرتوی ماورای بنفش، داشتن ثابت دی الکتریک متوسط و ضریب شکست بالای آن است. بهعنوان نمونه کاربردهای فراوانی در ساخت قطعاتی مانند گسیلندههای نوری فرابنفش، وریستورها، اقطعات لکترونیک شفاف با توان بالا، مبدلهای پیزوالکتریک، حسگرهای گازی، پنجرههای هوشمند، سلولهای خورشیدی، استفاده در صنعت چاپ (فتوکیی) و صنایع رنگرزی دارد.

نانو ساختارهای ZnO در طول سالهای اخیر بهخاطر خصوصیات قابل توجه آنها برای کاربردهای الکتریکی و فتوالکتریکی توجه خیلی زیادی را به خود جلب کرده اند. اکسید روی مادهای است بهرنگ سفید که در شرایط محیطی و تعادل ترمودینامیکی دارای ساختار ورتسایت میباشد . این ساختار دارای سلول واحد هگزاگونال با پارامترهای شبکه $a \ c$ و c با نسبت تقریبا $\sqrt{8/2} = c$ میباشد[۱]. اکسید روی یک نیمرسانای شفاف نوع n یکی از مهمترین نیمرسانای ترکیبات II-VI است

که دارای گاف انرژی مستقیم در حدود۳/۳ الکترون ولت است. مصارف زیاد اکسید روی مربوط بهعایق بودن آن در مقابل جریان الکتریسیته و هدایت ظرفیت حرارتی زیاد خاصیت

مقدمه

افزودن آلاینده های مناسب میتواند سبب تغییر اندازه گاف انرژی و ویژگی های فیزیکی آن شود، با توجه به کاربرد وسیع نانو پودر ZnO، بررسی اثر ناخالصیهای مختلف بر روی خواص آن از جمله Cu می تواند مفید باشد. بهر حال در این پژوهش، نانوپودر ZnO:Cu که با روش سل-ژل ساخته شده و اثرات ناخالصی مس بر ویژگیهای ساختاری ZnO مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش ساخت نمونهها

برای ساخت نانو پودر اکسید روی با افزودنی مس به روش سل- ژل با فرمولZn_{1-x}Cu_xO به ازائ (۰/۰۰، ۲۰/۰، (x =۰/۰۰) حلالها ایزوپروپانل و آب دو بار تقطیر (به نسبت مولی۲/۱ : [آب]/[ایزوپروپانول]) را با هم حل میکنیم [۲]. استات روی $Cu(CH_rCOO)_r$.HrO و استات مس $Zn(CH_rCOO)_r$.THrO را در دمای ^C ۲۰۰۵ بهمحلول اولیه اضافه کرده و حدود ۳۰ دقیقه در همان دما با همزن مغناطیسی حل میکنیم. دی اتانول آمین (پلیمر ساز) و اسید استیک (کمپلکس ساز) را جداگانه با هم حل می کنیم و به محلول اولیه اضافه می کنیم. بعد گذشت ۲۰ دقیقه به یک سل شفاف خواهیم رسید. در مر حله بعدی سل حاصل را در دمای C[°]۱۱۰ به مدت ۲ ساعت رفلاکس میکنیم. سپس برای ۱٤ ساعت در دمای °۹۰° سل را در حمام روغن قرار میدهیم تا حلالهای آن تبخیر شود. ژ ل بدست آمده را مستقیما در حرارت C°C قرار میدهیم و با افزودن مقدار کمی اسید نیتریک عمل سوختن را انجام مي گيرد. پودر حاصل را آسياب نموده و در دمای C°۰۰° تکلیس میکنیم.

نتايج

تعیین ساختار و اندازه ذرات- طرحهای پراش پرتوی x -برای نانو پودرهای حاصل از روش سل-ژل توسط دستگاه XRD با مشخصات لامپ CuKa (۱۹۵۰-۱۹۴۰) مورد مطالعه قرار گرفت .

در شکل ۱، طیف پراش پرتوی x برای نانوپودرهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ که در دمای C^o۰۰۰ تکلیس (x=۰/۰۰ تکلیس شده بودند ، آورده شده است. ساختار بلوری نمونهها با درصد ناخالصی (x=۰/۰۰، ۲) ورتسایت، به صورت تک فاز و بیشترین شدّت پراش مربوط به صفحهی [۱۰۱] است، ولی در **نانوپودرO**....Ca دار ثانویه منو کلینیک ظاهر میگردد. این فاز مربوط به افزودنی CuO می باشد و در نمودار شکل ۱ الف مشخص شده است. برای رسیدن به یک نمونه تک فاز با این درصد مس بایستی دمای تکلیس را بالا ببریم. از طرف دیگر افزودنی مس باعث افزایش ثابتهای شبکه(c) می شود. زیرا در ساختار ورتسایت، یون⁺² با شعاع یونی (NM=۱۳۰) بهجای يون⁺⁺ Zn با شعاع يوني (۲۰۴۰=۰/۰) جايگزين ميشود [۳]. همانطور که در شکل ۱ دیده می شود، با افزایش درصد مس عرض نيم يهناى (FWHM) قلّهها افزايش مى يابد، كه محاسبه اندازه میانگین نانو ذرات از رابطه شرر تاییدی بر این امر است (مشاهده می شود که با افزایش درصد مس اندازه نانو ذرات کاهش می یابد)



شکل ۱ : طرح پرا ش پرتو x از نانوپودرهای تهیّه شده در دمای تکلیس C°۰۰۰ و با درصدهای متفاوت مس، (a) ۰۰/۰۰ (c) ۰۰/۰۰

در جدول ۱ ثابتهای شبکه و میانگین اندازه ذرات برای نمونههای Zn_{۱-x}Cu_xO (۰/۰۰، ۰/۰۰، x=۰/۰۰) نشان داده شده است. ثابت شبکه با افزایش مقدار مس افزایش می یابد.

جدول ۱ : ثابت شبکه و اندازه میانگین نانوپودر اکسید روی با افزودنی مس

در صد مس	•/••	•/•٢	•/•0
مکان قله[۱۰۱](درجه)	377/222	397/39	۳٦/ ٣٥٢
پهنا در نيم ارتفاع(درجه)	• /٣٣٣	• /٣٣٦	٠/٣٣٩
ثابتهای شبکه(Å)	a=٣/٢٤٦٦	a=٣/٢٤٩٨٢	a=٣/٢٤٩٨٢
	C=0/19A1	C=0/7	C=0/7.771
اندازه میانگین ذرات(nm)	79/77	29/47	29/11

تصویر TEM از نانو ذرات اکسید روی در شکل ۲ نشان داده شده است. اندازه ذرات تقریباً ۳۰nm و شکل ذرات تقریبا بهصورت کروی هستند.

> شکل۲: عکس TEM از نانو پودر ZnO در دمای تکلیس ۲۰۰۰ ۵۰

<u>خواص اپتیکی</u> – برای بررسی اثر درصد ناخالصی مس بر ویژگیهای اپتیکی نانو ذرات به ویژه گاف انرژی نانو ذرات، از نمونهها طیف جذب اپتیکی در محدوده طول موج مرئی (۸۰۰۸۳۳) گرفته شده است. با افزایش درصد مس قله جذب بهسمت طول موجهای بزرگتر جابجا میشود، که در شکل ۳ مشاهده می شود. برای تعیین گاف اپتیکی Eg ابتدا از نمودار جذب بر حسب انرژی فوتون، دیفرانسیل می گیریم و نتایج در شکل ٤ رسم شده است. اولین بیشینه این نمودار در لبه افت نمودار در انرژی های پایینتر، نشان دهنده گاف انرژی است [٤]. همانطور که در شکل ٤ مشاهده می شود انرژی گاف با افزایش درصد مس

25 nm



شکل۳: نمودار جذب بر حسب طول موج برای نانو پودرها با درصد ناخالصی (a) ۰/۰۰ (a) ۰/۰۰ (c) ۰/۰۰ (c)



شکل ٤ : نمودار دیفرانسیل اول جذب نسبت به انرژی فوتون،بر حسب انرژی با درصد ناخالصی های (a) ۰۰/۰ (b) ۰۰/۰۰ (c)

جدول ۲ : گاف نوری نانو ساختارهای Zn_{1-x}Cu_xO

درصد مس	•/••	•/•0	•/•٢
مكان قله جذب (eV)	۳/۳۱۰	۳/۲۹٥	٣/٣٠٣
گاف نوري (eV)	۳/۲۹	۳/۲۷	٣/٢٨

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) اطلاعاتی در مورد ساختمان شیمیایی یک نمونه در اختیار ما میگذارد و هچنین برای شناسایی گروه های آلی مورد استفاده قرار میگیرد. طیف FTIR معمولا از نمونه هایی به شکل فیلم به دست میآید ، برای تهیه فیلم مناسب می توان مواد را به صورت بسیار ریز آسیاب کرده و سپس آن را با پودر KBr کاملا مخلوط و توسط دستگاه

پرس مخصوص به قرص مناسب برای گرفتن طیف FTIR تبدیل کرد.

این طیف برای نانو پودرهای حاصل (۰۰،۰ ۲۰،۰۰، ۰/۰۰=x) که در دمای C°۰۰۰ تکلیس شده اند در شکل ۵ اورده شده است.



شکل ۵: طیف FTIR عبوری برحسب عدد موج برای نانو پودرهای ۰/۰۰ (c)، ۰/۰۲ (b)، ۰/۰۰ (a) Zn_{۱-x}Cu_xO

در طیف FTIR یک نوار جذبی قوی حول¹⁻E&CC دیده می شود که مربوط به پیوند Zn-O است. با حضور ناخالصی مس علاوه بر این، یک نوار جذبی دیگر در ¹⁻T۱۲cm مشاهده می شود.

با استفاده از طیف عبوری، طیف بازتاب را بدست می آوریم و در شکل ٦ رسم شده است. فرورفتگی در طیف بازتاب متناظر با قله ای در جذب است .



شکل ۲ : طیف بازتابی محاسبه شده از طیف عبوری طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه بر حسب عدد موج بین محدودهی ^{(-۱}۰۰۰ ۲۰۰۰ - ۰۰.۶.(a)۰۰۰ (b) ۰/۰۲ (c), ۰/۰۲ (b)

نتيجه گيري

در این تحقیق با استفاده از روش ساخت سل-ژل نانو پودرهایی با فرمولZn_{1-x}Cu_xO به ازائ (۰/۰، ۲/۰۰، ۲/۰۰ تهیه گردید. در این روش پودرهای بسیار ریز باهمگنی بسیار بالا در کنارمراحل ساخت کمتر و همچنین به دلیل عدم لزوم آسیاب کاریهای طولانی تولید می شود. از مزایای دیگر این روش پایین بودن دمای تکلیس آن است. نمونهها در دمای C⁰۰۰۰ تکلیس شدند. نتایج مشخصهیابی نشان می دهد که نانو پودر با ترکیب مدند. مای Zn./۱۵Cu./۰۵ حلالیت مس در ZnO لازم است دمای تکلیس را افزایش داد.

مرجعها

- U.Qzgur, "A comprehensive review of ZnO materials and devices" J. Appl. Phys. 98. 041301 (2005).
- [2] K Das ,S Ray ,S Chaudhuri & A B Maity,"Structural and luminescence properties of sol-gel derived Cu doped ZnO films" Indian Jornal of Pure & Applied Physics Vol. 47, (2009) 377-382
- [3] G. Z. Xing, J. G. Tao, G. P. Li, Z. Zhang, L. M. Wong, S. J. Wang, C. H. A. Huan and T. Wu, "Doping Cu into ZnO Nanostructures" Indian Jornal of Pure & Applied Physics Vol. 47, (2009) 378-379
- [4] A. E. Morales, E. S. Mora and U. Pall, "Use of diffuse reflectance spectroscopy for optical characterization of un-supported nanostructure" Revista Mexicana de F'isicas, Vol. 53 (2007)18-22.